# Comunicado de prensa

## KIOXIA presentará la tecnología XL-FLASH de 3.ª generación, la nueva generación de memoria flash de baja latencia y alto rendimiento para IA en el KIOXIA Forum

El prototipo alcanza una latencia media de lectura de 3 microsegundos




**Alemania, Düsseldorf, 25 de noviembre de 2026 –** KIOXIA Europe GmbH ha anunciado hoy que KIOXIA Corporation presentará un prototipo de su tecnología XL-FLASH™ de 3.ª generación, la nueva generación de su memoria flash de baja latencia y alto rendimiento para aplicaciones de IA, en el KIOXIA Forum en Tokio el 26 de noviembre de 2026.

XL-FLASH™ presenta una latencia de lectura significativamente menor y una mayor resistencia de escritura que la memoria flash NAND convencional, y se está desarrollando para su uso como un nuevo nivel de memoria que cubra la brecha entre el almacenamiento y la DRAM en términos de rendimiento, capacidad y coste.

La memoria XL-FLASH™ de 3.ª generación aprovecha la tecnología CBA (CMOS unido directamente a la matriz), una característica clave de la memoria flash 3D BiCS FLASH™ de KIOXIA, para ofrecer aproximadamente un 70 % más de densidad de bits que la memoria flash XL-FLASH™ de 2.ª generación, al tiempo que mantiene un alto rendimiento.

También alcanza una latencia media de lectura de 3 microsegundos, menos de una décima parte de los productos TLC de BiCS FLASH™ de 8.ª generación de KIOXIA(1). Además, la eficiencia energética para lecturas en unidades de 512 bytes se ha mejorado aproximadamente un 135 % en comparación con la memoria flash XL-FLASH™ de 2.ª generación(2). Las muestras para evaluación funcional están programadas para enviarse a clientes seleccionados en marzo de 2027.

El auge de las aplicaciones que hacen un uso intensivo de datos, incluida la IA generativa, ha impulsado un rápido aumento de la demanda de memoria de alta capacidad en los sistemas informáticos. Sin embargo, almacenar la mayor parte de los datos en DRAM plantea dificultades en cuanto a capacidad, coste y consumo energético. Al aprovechar la latencia de lectura y la eficiencia energética de XL-FLASH™, las nuevas arquitecturas de sistemas pueden almacenar datos adecuadamente en función de la frecuencia de acceso y los requisitos de rendimiento, complementando la DRAM o reemplazando una parte de ella por memoria flash.

«A medida que la IA continúe impulsando la demanda de capacidades de memoria ampliadas, este enfoque ayudará a satisfacer estos crecientes requisitos, reduciendo al mismo tiempo el coste total de propiedad (TCO) de servidores de IA, centros de datos y una amplia gama de otras aplicaciones», afirmó Axel Störmann, vicepresidente y director de tecnología de KIOXIA Europe GmbH.

KIOXIA seguirá desarrollando la tecnología XL-FLASH™, al tiempo que impulsará su uso en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen las unidades SSD con IOPS elevadas y los módulos de expansión de memoria compatibles con Compute Express Link (CXL). Mediante estas iniciativas, KIOXIA pretende crear un nuevo nivel de memoria que cubra la brecha entre la DRAM y el almacenamiento convencional.

###

**Notas:**

1: Comparación de la latencia de lectura basada en mediciones de los productos TLC de 1 Tb BiCS FLASH™ de 8.ª generación de KIOXIA y un prototipo XL-FLASH™ de 3.ª generación. Según resultados de pruebas internas de KIOXIA.

2: Comparación de la eficiencia energética para lecturas en unidades de 512 bytes basada en mediciones de productos XL-FLASH™ de 2.ª generación y un prototipo XL-FLASH™ de 3.ª generación. Según resultados de pruebas internas de KIOXIA.

Las siguientes marcas comerciales, servicios y/o nombres de empresas (Compute Express Link, CXL, Compute Express Link Consortium, Inc.) no han sido solicitadas, registradas ni creadas por KIOXIA Europe GmbH, ni tampoco son propiedad de la empresa o de empresas afiliadas al grupo KIOXIA. No obstante, pueden haber sido solicitadas, registradas, creadas y/o ser propiedad de terceros en diversas jurisdicciones y, por tanto, estar protegidas frente a cualquier uso no autorizado.

La información contenida en este documento, incluidos los precios y las especificaciones de los productos, el contenido de los servicios y la información de contacto, es válida en la fecha de su publicación, pero está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Acerca de KIOXIA Europe GmbH**

KIOXIA Europe GmbH es la filial europea de KIOXIA Corporation, un proveedor líder mundial de memorias flash y unidades de memoria de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash NAND hasta la popular memoria flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de la empresa está moldeando el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los smartphones avanzados, los ordenadores de sobremesa, los sistemas automotrices, los centros de datos y los sistemas de IA generativa. **Visite nuestro sitio web de KIOXIA**

**Datos de contacto para la publicación:**

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Alemania

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: KIE-support@eu.kioxia.com

**Datos de contacto para consultas editoriales:**

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

**Publicado por:**

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tel.: +49 (0)172 617 8431

Correo electrónico: birgit.schoeniger@pretzl.com

Web: www.pretzl.com